高出カマイクロ秒パルスレーザ照射による

ピーニングパラメータ計測

大阪大学 レーザー科学研究所教授 重森 啓介(平成 28 年度 一般研究開発助成 AF-2016214)

キーワード:ピーニング、マイクロ秒レーザ、衝撃波

1. 研究の目的と背景

パルスレーザをもちいたレーザピーニングは,高強度レ ーザによって生成するアブレーション圧力により衝撃波 を駆動し,材料中に圧力波を伝播させて残留応力を制御す る手法であり,従来のショットピーニングよりも制御性や 発生圧力の高さなど優位点が多く,幅広い応用がすすめら れている.このレーザピーニングの性能のうち,衝撃波を 材料中にいかに深く浸透させるか(深層制御)が材料強度 向上の鍵となっている.例えば,レーザピーニングで用い られるレーザ装置のパルス幅はおおよそ~10 ns であり, この場合に 10 GPa (10 万気圧)の衝撃波を発生させた場 合の SUS 中での衝撃波伝播距離(衝撃波速度×レーザのパ ルス幅)は約 100 µm 程度である.この伝播距離を深くす る一つの手段として,照射レーザの大出力化によって強い

(圧力の高い)衝撃波を発生させるというアプローチがあ る.しかしながら,材料中に伝播する衝撃波の圧力はその 伝播距離のべき乗で急激に減衰するため,初期圧力を高く することだけでは効果は薄い.そこで,衝撃波伝播距離を 得るもう一つの手法として,パルス幅を長くすることによ り衝撃圧縮の持続時間を長くすることが考えられる.しか しながら,このような長パルス幅条件での材料変性にかか わる研究はこれまで行われておらず,レーザ照射による衝 撃波や熱波などの伝播に関する基礎的な物理過程に関す る知見が不足しているのが現状である.

レーザ照射材料中を伝播する衝撃波は,上記の通り圧力 を減衰しつつ空間的に発散しながら伝播する.その伝播プ ロセスを正しく理解することがレーザピーニングの成功 の鍵を握る. さらに、この衝撃波とは独立してレーザピー ニング特有の問題を評価する必要がある.レーザ照射の場 合,アブレーションの反作用によって材料中に衝撃波を駆 動するため、衝撃波通過後におけるアブレーションプラズ マの熱(熱波)の影響を考慮する必要がある.フェムト秒 レーザのような極めて短いパルス幅の照射条件下ではこ の効果が無視できるほどであるが、パルス幅が長くなれば なるほどアブレーションプラズマの総量が増加するため, この熱(熱波)の影響を正確に得る必要がある.本研究で 狙いとしている長パルスレーザを用いた深層加工では,上 記のような効果を特に正しく理解しなくてはならない.こ れまでパルスレーザによるピーニングだけでなく,一般的 な加工でもナノ秒~数10ナノ秒でのパルス幅における研

究や技術開発は数多くあるものの,本研究のようなマイク ロ秒オーダーでの実験的研究はほとんど行われていない. これらの点を鑑み,申請者らがこれまで行ってきた高精度 レーザ駆動衝撃波計測の活かし,これまで明らかになって いなかった長パルスレーザ照射条件下の材料中でのピー ニングパラメータ(圧力,温度など)を計測することによ り,ピーニング性能を大きく向上させるための物理的知的 基盤を得るのが本研究の目的である.

2. 実験方法

2・1 大出力マイクロ秒パルスレーザの開発

図1はレーザシステムの光学系の配置を示している。な お、波長は1053 nm、ビーム径は50 mm となっている、波 長 1053 nm に対して反射率 20%のフロントミラーと反射 率100%のリアミラーの間に増幅器を2台設置する形でレ ーザシステムの共振器としている. レーザ制御器のポテン ションメーターの値に応じて励起電圧を変化させること ができ、励起電圧に応じてレーザエネルギーは変化する. 本研究では特に記載がない限り、励起電圧 5.4 kV で照射 実験を行っている、図1の出力側の0.1%透過ミラーの透 過光をエネルギーメーターで測定することでレーザエネ ルギーを算出し、エネルギーメーター表面の散乱板からの レーザ光をフォトダイオードで測定することでパルス波 形の計測を行った. 加えて, フロントミラーとリアミラー の間の光軸の調整及び、ターゲット表面での集光確認のた めに, He – Ne レーザと CCD カメラによるアライメント システムを設置した.



図1 本研究で用いたレーザシステム概略

増幅器のみの場合,発振時間波形はフラッシュランプの 発光による波形(パルス幅:数100μs)となり,本研究で 行うピーニングに必要な照射強度が得られない.そこで, 増幅器とリアミラーの間に水平偏光のみを透過する偏光 板と電圧印加によって屈折率が変化する径 50 mmのポッ ケルスセルを設置する Q-switch システムを導入した.ポ ッケルスセルは Gooch & Housego 社製の Large Aperture KD*P Cell(口径 50 mm)を用いており,λ2板として用 いるためには 6.9 kV,λ/4板として用いるためには 3.45 kV の電圧を印加しておく必要がある.本研究において,パル スレーザの発振を抑える光シャッターとして用いるため に水平偏光のみを透過する偏光板と組み合わせる場合は ポッケルスセルをλ/4板として用いる必要があるため, 3.45 kV の電圧を印加するように設定した.得られたパル ス波形を図2に示す.



図2 本レーザシステムにおけるパルス波形

2・2 衝撃波パラメータ計測システム

本研究では、図 3 に示すような VISAR (Velocity Interferometer System for Any Reflector) 計測系 ¹⁾を用いて計 測を行った. プローブレーザには出力 500 mW, 波長 532 nmのCW レーザ(UniKLasers 社製: Duetto532)を用いてい る(図 4.22). エタロンの厚みは 35 mm であり、この際の速 度感度 VPF(Velocity per Fringe)は1.28 km/s である. つまり, 得られた干渉縞(Fringe)が 1 Fringe 分シフトした場合には その裏面速度が 1.28 km/s となる. VISAR 測定において, 詳細な解析を行うためには適切な干渉縞密度を選択する 必要がある.しかし、レーザ光は非常にコヒーレンスの高 い光であるため, 試料裏面への入射の仕方により, 干渉計 の条件に関わらず,至る所で干渉を示しために適切な干渉 縞密度を実現する上で問題となる. そのため, プローブレ ーザの空間コヒーレンスを崩すため,光ファイバーを通過 させている.また,エタロンのハーフミラーコート面での 光が試料裏面へ戻ってしまうことを防ぐため、図 4.21(b) に示すように干渉計を平行四辺形に組んでいる.対物レン ズは無限遠補正のレンズ(L1)を用いており、アクロマティ ックレンズ(色消しレンズ)(L2)で M1, M2 ミラー上に試料 裏面の像を結像するように設置している.レンズ(L3)によ って M1, M2 ミラー上の像をストリークカメラ(浜松ホ トニクス製: C7700)に結像してある. M2 ミラーを平行 移動させ,式(4.7)の条件を満たす位置に至ると干渉縞の コントラストが最大になる.また,M2 ミラーを傾ける方 向に応じて干渉縞のシフトする方向も変化するため,試料 裏面が加速するのは干渉縞がどちらにシフトした時なの かを事前に調査する必要がある.ストリークカメラはその 光感度の高さから,パルスレーザのような非常に強い光が 入った場合にはカメラが損傷する恐れがある.そのため, 対物レンズ(L1)とビームスプリッターの間に波長 1053nm の光に対する透過率が1%以下のフィルターを5枚設置し, 照射試料を貫通したパルスレーザがストリークカメラに 侵入しないようにしている.





3. 実験結果

3・1 先行加熱の評価

ポッケルスセルと偏光板による Q-switch を導入し,厚 さ 200 µm の Al 試料への照射実験を行った結果, 試料の 照射痕を観察すると溶解している痕跡が見られ,熱の影響 が生じていることが予想された.この原因の一つとして, Q-switch が完全な光シャッターとして機能しておらず、メ インパルスの前に漏れ光が発生し,その結果として先行加 熱が生じている可能性が考えられた. そのため, サブマイ クロ秒パルスレーザシステムによる漏れ光の発生で先行 加熱が生じているかを金属試料に照射実験を行い,調査し た. なお、漏れ光の有無を確かめるため、Q-switchを動作 させずに偏光板とポッケルスセルを光シャッターとして 動作させ、レーザエネルギーやレーザ波形を計測した.図 4 (a)に示すように厚さ3 µm モリブデン薄膜を大阪大学・ レーザ科学研究所のレーザ加工機で短冊状(1 mm×5 mm) に加工し,透明体である合成石英ガラスに導電性銀ペース トで銅線と共に接着した. 作製したモリブデン試料には図 4(b)に示すようにレーザを照射する. モリブデン試料に対 してレーザ照射面側に透明体材料である合成石英ガラス が置いてあるが、この合成石英ガラスによるレーザ誘起プ ラズマの閉じ込め(後述)は生じない.これは漏れ光の温度 がプラズマ発生温度(6500 K~ 9000 K)に達しないためで ある. モリブデンは良導体であり, 電気抵抗値が小さいこ

とから電気抵抗値の精密計測を行うためにホイートスト ンブリッジ回路を介してオシロスコープで計測を行った.



図4 先行加熱計測系の概略

図 5 は照射実験中のモリブデン試料の電気抵抗率の変 化をオシロスコープから得られたものを示す.時間 0 µs でメインパルスが到達することから 200 µs 前から加熱が 始まっていることがわかる.この結果から,サブマイクロ 秒パルスレーザシステムで生じた漏れ光によって,メイン パルス直前までに 980±100 K の先行加熱が生じること が確認された.



図5 先行加熱温度計測結果

3・2 衝撃波パラメータの評価

図 6(a)に AI 薄膜(厚さ 400 µm) へ照射実験を行った(@1 mm 集光)際の VISAR 測定の結果を示している.このときの掃引時間は 10 µs であり,時間分解能は 140 ns であった. 図 6(b)はこのレーザ照射の際に得られたレーザ波形,図 6(c)は照射後の AI 試料である.得られたレーザェネルギーは 85 J,パルス幅は 100 ns であった.レーザ照射後に干 渉縞の乱れが確認できるが,シフトは確認されないことから試料裏面に観測に有意な裏面速度が到達していないことがわかる.また,図 7(a)に Ti 薄膜(厚さ 100 µm) へ照射 実験を行った(@1 mm 集光)際の VISAR 測定の結果を示 す.このときの掃引時間は 2 µs であり,時間分解能は 45 ns であった.図7(b)はこのレーザ照射の際に得られたレーザ 波形,図7(c)は照射後のTi 試料である.得られたレーザ エネルギーは25J,パルス幅は100 nsであった.Ti 試料 での照射実験の際,レーザ径が半分(面積は1/4)であった ため,エネルギーが前者に比べて1/4ほど小さくなる.Ti 試料への照射実験においても干渉縞のシフトが確認され ないことから,試料裏面に観測に有意な裏面速度が到達し ていないことがわかる.





図6 Al 試料への照射実験から得られた結果







図7 Ti 試料への照射実験から得られた結果

3・3 プラズマ閉じ込め効果による圧力の増大

直接照射法におけるレーザ誘起衝撃波はレーザ照射後 (レーザ入射からパルス幅の時間の後)から希薄波の急速 な進行が始まり、衝撃波に希薄波が追いついた場合、衝撃 波が急激に減衰する.一方で、試料のレーザ照射面側を透 明体媒質で覆った場合には、衝撃波を追いかける希薄波の 伝搬を遅らせることが可能になる.また,直接照射法では レーザ誘起プラズマが真空中で自由に拡散してしまうた め、断熱膨張によってプラズマは急速に冷却されてしまう. そのため, 圧力持続時間はレーザのパルス幅と同等になる ことが知られている.先行研究²⁾において、レーザ誘起プ ラズマをガラスなどの透明体に閉じ込めることで,直接照 射を上回る圧力及び,パルス幅の2倍以上の圧力持続時間 が達成されることが報告されている.以上の理由から,透 明体媒質で試料を覆うプラズマ閉じ込め法の導入により, 開発したレーザシステムの課題を克服し,直接照射以上の 高圧力と圧力保持時間を達成できる可能性がある.



図8 プラズマ閉込法における試料セットアップ概略

図 9(a)は図 5.6 の試料(Ti 厚み 50 µm)に集光径 1 mm で レーザを照射した際の VISAR 測定の結果を示している. このときの掃引時間は 2 µs であり,時間分解能は 40 ns で あった.干渉縞のシフトが確認されることから試料裏面に 衝撃波が到達していることがわかる.試料裏面に到達する 衝撃波の圧力の時間変化を図 9(b)に示す. Ti の Co と S はそれぞれ 6.16 km/s, 3.19 km/s である.また,図 9(c)に 示すように照射後の試料に強い圧縮の痕跡が確認できる. この結果から,レーザ誘起プラズマの閉じ込め法の導入に より,最大で 15±1 GPa の圧力が試料裏面に到達している ことがわかった.また,10±1 GPa 以上の圧力が 200 ns 以 上保持されていることがわかった.



図 9 プラズマ閉じ込め法を導入した Ti 試料@厚さ 50 μm への照射実験の結果

4. 結び

本研究では、これまで適用されていなかったマイクロ 秒オーダーのパルス幅レーザにおけるピーニングパラメ ータの計測を実施した. 100 J 級の出力をもつユニークな 装置系を開発し、衝撃波パラメータをはじめとしたレーザ ピーニングに重要なパラメータの計測を実施し、試料や照 射強度依存性を得た.また圧力増大の方策のためにレーザ プラズマ閉込法を適用し、有意な効果を証明した.

謝 辞

本研究の遂行にあたり,援助いただきました公益財団法人 天田財団に深く感謝いたします.また,実験実施にあたっ て尽力いただきました弘中陽一郎特任研究員,大学院学生 の藤原宇央氏に御礼申し上げます.

参考文献

- L. M. Barker and R. E. Hollenbach., J. Appl. Phys, 43, 4669, 1972
- 2) R. Fabbro, et al., J. Appl. Phys, 68, 1990